

УДК 537.535

© 1990

МЕХАНИЗМЫ УШИРЕНИЯ ЛИНИЙ ЭПР ПОЛЯРОННЫХ ЦЕНТРОВ В $\text{LiNbO}_3 : \text{Ti}$ ПРИ РАДИАЦИОННОМ И ТЕРМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИЯХ

Л. Г. Ракитина, И. М. Зарыцкий, Г. Корради,¹ К. Нолгар¹

Исследованы угловые и температурные зависимости спектров ЭПР Ti^{3+} , Nb^{4+} , O^- в $\text{LiNbO}_3 : \text{Ti}$, возникающих после γ -облучения и термоотжига. Измерения проводились на частоте $\nu = 9.2$ ГГц при $T = 4.2 \div 250$ К. Обнаружено, что ширина линий ЭПР Ti^{3+} и O^- зависит от температуры по закону $\Delta H_{pp}(T) = \Delta H_{pp}(\text{O}) - A \exp(-E/k_B T)$, где $E/k_B \approx 115$ К для Ti^{3+} и $E/k_B \sim 10$ К для O^- . С ростом T форма линии ЭПР Ti^{3+} преобразуется от гауссовой к лоренцевой. Установлено, что угловая зависимость ΔH_{pp} Ti^{3+} и Nb^{4+} обусловлена разбросом g -факторов, определены величины $\langle \Delta g_z^2 \rangle$ и $\langle \Delta g_x^2 \rangle$ и оценены соответствующие вариации параметров кристаллического поля и ковалентности. Совокупность полученных экспериментальных данных подтверждает высказанное ранее предположение о полярной природе собственных дефектов Nb^{4+} и O^- в LiNbO_3 . Впервые получены данные о полярной природе примесных центров Ti^{3+} .

Монокристаллы LiNbO_3 , легированные Ti , широко применяются в квантовой электронике в качестве оптических волноводов [1], рабочие характеристики которых существенно зависят от наличия дефектов в кристаллической матрице. Особое значение имеет использование таких устройств в экстремальных условиях, в частности при радиационном и термическом воздействиях. Эксперименты по исследованию $\text{LiNbO}_3 : \text{Ti}$ после отжига в различных средах (в атмосфере водорода, в вакууме) при $T = 700 \div 1300$ К показали, что Ti^{4+} ($3d^0$) перезаряжается в Ti^{3+} ($3d^1$) [2, 3]. В [4] впервые наблюдались центры Ti^{3+} после γ -облучения при 77 К, которые являются аксиально-симметричными, как и при термоотжиге. Наряду с Ti^{3+} в $\text{LiNbO}_3 : \text{Ti}$ после отжига наблюдаются спектры ЭПР Nb^{4+} -центров [1-3], а после γ -облучения — O^- - и Nb^{4+} -центров [4]. В [4-8] описаны O^- - и Nb^{4+} -дефекты, однако природа уширения линий ЭПР центров типа O^- , Nb^{4+} и Ti^{3+} , а также взаимодействие этих центров с окружением пока не выяснены.

Целью настоящей работы является выяснение механизмов уширения линий ЭПР Ti^{3+} , O^- и Nb^{4+} -центров и получение дополнительных данных об их природе после термоотжига в вакууме и γ -облучения при 77 К.

1. Методика эксперимента

Монокристаллы LiNbO_3 выращивались в Исследовательской лаборатории физики кристаллов АН Венгрии (г. Будапешт) с помощью автоматизированного метода Чохральского с добавлением в расплав примеси Ti в концентрации 10^{-3} моль/моль. Образцы подвергались вакуумному отжигу при 1300 К в течение 1 ч и γ -облучению при 77 К от источника ^{60}Co дозой 10 Мрад.

Исследования ЭПР проводились при 4.2—250 К на радиоспектрометре Е-12 «Вариан» в X -диапазоне ($\lambda \approx 3$ см).

¹ Исследовательская лаборатория физики кристаллов АН Венгрии, Будапешт.

2. Результаты эксперимента

В $\text{LiNbO}_3 : \text{Ti}$ после вакуумного отжига обнаружены спектры ЭПР Ti^{3+} , аналогичные наблюдавшимся в [1-3]. Нами установлено, что при $\mathbf{H} \parallel \mathbf{C}_3$ в интервале температур 4.2—30 К линия имеет гауссову форму, при $T = 30 \div 70$ К ее форма промежуточная между лоренцевой и гауссовой, а при $T \geq 70$ К линия является лоренцианом. Следует отметить, что сигнал ЭПР Ti^{3+} -центров исчезает при $T \sim 150$ К. Спектр ЭПР Ti^{3+} описывается спин-гамильтонианом

$$\mathcal{H} = g_{\text{eff}} \beta \mathbf{H} \mathbf{S} \quad (1)$$

с $S = 1/2$, где

$$g_{\text{eff}} = (g_{\parallel}^2 \cos^2 \theta + g_{\perp}^2 \sin^2 \theta)^{1/2}, \quad (2)$$

$g_{\parallel} = 1.966 \pm 0.002$, $g_{\perp} = 1.862 \pm 0.002$, θ — угол между направлениями магнитного поля \mathbf{H} и осью \mathbf{C}_3 кристалла.

Проведены исследования угловых и температурных зависимостей ширин ΔH_{pp} линий ЭПР Ti^{3+} -, O^- - и Nb^{4+} -центров (рис. 1, 3). Кривые 1,

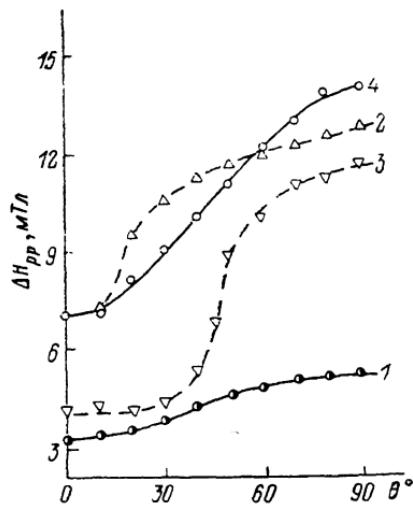


Рис. 1. Угловые зависимости ширин линий ЭПР в кристаллах LiNbO_3 . Точки — эксперимент, сплошные линии 1, 2 — теория.

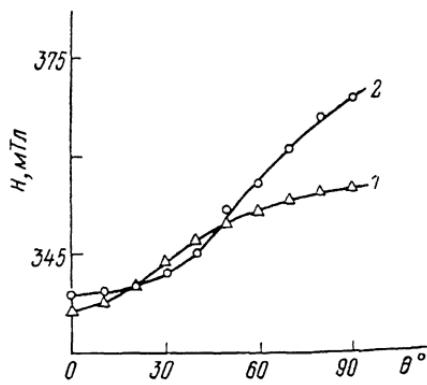


Рис. 2. Угловые зависимости положения линий ЭПР в кристаллах LiNbO_3 при 77 К.
1 — Ti^{3+} -центры, 2 — Nb^{4+} -центры (указано положение центра тяжести спектра).

(рис. 1) отражают изменение ширины линии ЭПР Ti^{3+} -центров, возникающих после термоотжига, при $T = 22$ и 77 К соответственно в зависимости от угла θ . Кривая 1 соответствует гауссовой форме линии ЭПР, а кривая 2 — лоренцевой. Кривая 3 записана при 77 К, как и кривая 2, но способ образования Ti^{3+} -центров здесь иной: Ti^{3+} -центры возникают после низкотемпературного γ -облучения. Ширина линии ЭПР Ti^{3+} в этом случае гораздо меньше при $\mathbf{H} \parallel \mathbf{C}_3$ $\Delta H_{pp} \approx 4$ мТл, в то время как ширина линии Ti^{3+} , образованного после вакуумного отжига, $\Delta H_{pp} \approx 7$ мТл для этой же ориентации. Кривая 4 представляет собой угловую зависимость ширины первой (низкополевой) линии сверхтонкой структуры Nb^{4+} -центров из десяти, наблюдаемых экспериментально ($I_{\text{Nb}^{4+}} = 9/2$, распространенность 100 %). Nb^{4+} -центры, так же как и Ti^{3+} -центры, являются аксиальными и их спектр ЭПР описывается формулами (1), (2) с $g_{\parallel} = 1.950 \pm 0.005$ и $g_{\perp} = 1.790 \pm 0.005$.

Анализ угловых зависимостей ширин линий ЭПР Ti^{3+} при 22 К и Nb^{4+} при 77 К (рис. 1) показывает, что они коррелируют с угловыми зависимостями положения этих линий (рис. 2). Отсюда можно сделать вывод, что ширины линий ЭПР Ti^{3+} и Nb^{4+} обусловлены разбросом g -факторов этих центров. В этом случае они могут быть описаны с помощью следующего выражения [9]:

$$\Delta H_{pp}(0) = \frac{2}{\sqrt{3}} \sqrt{\Delta H_0^2 + \frac{\langle \Delta g_{\text{eff}}^2 \rangle}{g_{\text{eff}}^2} H_0^2}, \quad (3)$$

где ΔH_0 — ширина линии, не зависящая от θ ; H_0 — резонансное поле; $\langle \Delta g_{\text{eff}}^2 \rangle = \langle \Delta g_{\parallel}^2 \rangle \cos^2 \theta + \langle \Delta g_{\perp}^2 \rangle \sin^2 \theta$; $\langle \Delta g_{\parallel}^2 \rangle$ и $\langle \Delta g_{\perp}^2 \rangle$ — среднеквадратичные разбросы g -факторов. Из сопоставления (3) с угловой зависимостью ΔH_{pp} были получены значения $\langle \Delta g_{\parallel}^2 \rangle \approx 1.3 \cdot 10^{-5}$, $\langle \Delta g_{\perp}^2 \rangle \approx 3.6 \cdot 10^{-4}$, $\Delta H_0 \approx 2.7$ мТл для Ti^{3+} и $\langle \Delta g_{\parallel}^2 \rangle \approx 1.3 \cdot 10^{-5}$, $\langle \Delta g_{\perp}^2 \rangle \approx 2.5 \cdot 10^{-3}$ и $\Delta H_0 \approx 6$ мТл (для первой линии СТС) для Nb^{4+} -центров. Необходимо отметить, что формула (3) справедлива для линий гауссовой формы, что для Ti^{3+} соответствует кривой 1 (рис. 1). Форма же линии для Nb^{4+} в исследуемом интервале температур 20—80 К не меняется, а кривая 4 также хорошо описывается (3).

На рис. 3 представлена температурная зависимость уширения $[\Delta H_{pp}(T) - \Delta H_{pp}(0)]$ линий ЭПР центров Ti^{3+} и O^- . Заметим, что ширина и g -фактор линии ЭПР O^- являются изотропными

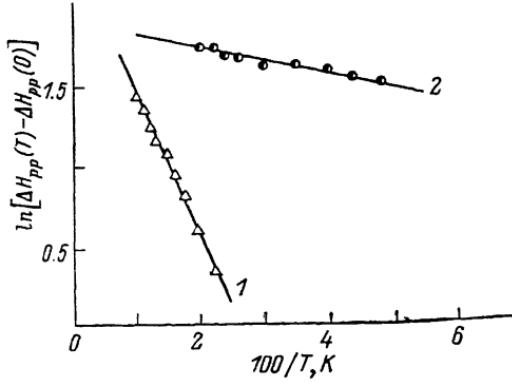


Рис. 3. Температурные зависимости уширений линий ЭПР в кристаллах $LiNbO_3$ при $H \parallel C_3$ центров Ti^{3+} (1) и O^- (2).

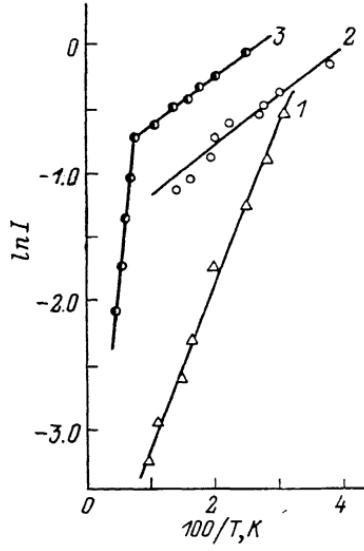


Рис. 4. Температурные зависимости интегральной нормированной интенсивности линий ЭПР в кристаллах $LiNbO_3$ при $H \parallel C_3$ центров Ti^{3+} (1), Nb^{4+} (2), O^- (3).

Данные для O^- -центров в интервале 130—250 К взяты из [4].

и составляют ~ 15 мТл и 2.030 ± 0.002 [4] соответственно. Видно, что ширина линий ЭПР этих центров зависит от температуры по закону

$$\Delta H_{pp}(T) = \Delta H_{pp}(0) + A \exp(-E/k_B T), \quad (4)$$

где $E/k_B \approx 115$ К для Ti^{3+} в температурном интервале 20—100 К и $E/k_B \approx 10$ К для O^- в температурном интервале 4.2—80 К. Температурное уширение линий ЭПР Nb^{4+} -центров незначительное, поэтому выводы о его значении E/k_B сделать нельзя.

На рис. 4 представлены температурные зависимости интегральных нормированных интенсивностей линий ЭПР (определенные как $I' \Delta H_{pp}^2$, I' — амплитуда производной спектра ЭПР) при $H \parallel C_3$ для Ti^{3+} , Nb^{4+} - и O^- -центров (кривые 1, 2, 3 соответственно) в интервале температур 20—250 К. Определены $E/k_B \approx 115$ К для Ti^{3+} и $E/k_B \approx 40$ К для Nb^{4+} -центров при 20—100 К. Кривая 3 имеет излом, свидетельствующий о различных энергиях активации O^- -центра: $E/k_B \approx 40$ К при 40—130 К и $E/k_B \approx 660$ К при 130—250 К.

3. Обсуждение результатов

Как показано в [2], значения g -факторов ионов Ti^{3+} и Nb^{4+} в $LiNbO_3$ соответствуют состояниям $3d^1$ и $4d^1$ соответственно расщепленным сильным октаэдрическим кристаллическим полем в присутствии слабого тригонального искажения. В этом случае [10]

$$g_{\parallel} = 2 - 2\delta^2(2 + k), \quad g_{\perp} = 2 - \sqrt{8}k\delta - 2\delta^2, \quad (5)$$

где δ — параметр, определяемый из соотношения $\tan 2\delta = \sqrt{2}\lambda/(\Gamma + 1/2\lambda)$; λ — константа спин-орбитальной связи; Γ — величина тригонального расщепления; k — параметр ковалентности.

Поскольку ширины линий ЭПР Ti^{3+} и Nb^{4+} определяются разбросом g -факторов, из (5) могут быть определены соответствующие разбросы значений δ и k : $\Delta\delta \approx 3.5 \cdot 10^{-3}$, $\Delta k \approx 5.4 \cdot 10^{-2}$ для Ti^{3+} и $\Delta\delta \approx 3 \cdot 10^{-5}$, $\Delta k \approx 1.7 \cdot 10^{-1}$ для Nb^{4+} . Из данных $\Delta\delta$ могут быть найдены значения $\Delta\Gamma \sim 14 \text{ см}^{-1}$ для Ti^{3+} и $\Delta\Gamma \sim 0.5 \text{ см}^{-1}$ для Nb^{4+} . Вариации этих величин в $LiNbO_3$ могут определяться несовершенствами структуры кристаллов электрической либо упругой природы.

Уширение линии ЭПР Ti^{3+} за счет разброса g -факторов приводит к гауссовой форме линии. С ростом T линия превращается в лоренциан, что свидетельствует о включении спин-релаксационных процессов. Активационный характер спин-релаксационных процессов (рис. 3, 4) с низкими энергиями активации $E/k_B \sim (10-100) \text{ K}$ указывает на статическую нестабильность изучаемых центров. Наиболее вероятной причиной такой нестабильности является поляронная природа центров Nb^{4+} , O^- [5] и Ti^{3+} , а спин-релаксационный процесс естественно связать с термически активированным прыжковым движением поляронного состояния. Более высоконергетический процесс с $E/k_B \sim 660 \text{ K}$ для O^- (рис. 4) может быть обусловлен термическим возбуждением дырки в зону проводимости.

Поскольку в отличие от собственных дефектов Nb^{4+} и O^- ион Ti^{3+} является примесным центром, его поляронная природа на первый взгляд противоречит отсутствию трансляционной симметрии в расположении примесных ионов в решетке $LiNbO_3$. Однако это противоречие может быть устранено, если $3d^1$ -электрон (полярон) Ti^{3+} может участвовать в термически активированном движении по подсистеме ионов Nb^{5+}/Nb^{4+} , что возможно лишь в случае замещения Ti^{4+} ионов Nb^{5+} .

Из рис. 1 видно, что после вакуумного отжига ширина линии ЭПР Ti^{3+} значительно больше, чем при низкотемпературном γ -облучении при температуре измерения 77 К и при всех значениях θ . Форма линии здесь лоренциан. Угловую зависимость ΔH_{pp} не удается аппроксимировать по формуле (3). Можно предположить, что температурное уширение, зависящее от θ , здесь связано с угловой зависимостью упомянутого выше спин-релаксационного процесса двигательного типа.

Список литературы

- [1] Зиллинг К. К., Надолинный В. А., Шашкин В. В. // Изв. АН СССР, неорг. матер. 1980. Т. 16. № 4. С. 701—706.
- [2] Juppe S., Schirmer O. F. // Phys. Lett. A. 1986. V. 117. N 3. P. 150—152.
- [3] Агамалиян Н. Р., Асатрян Г. Р., Карагезян С. М. и др. // ЖПС. 1988. Т. 49. № 6. С. 1016—1019.
- [4] Корради Г., Полгар К., Зарицкий И. М. и др. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 9. С. 115—122.
- [5] Schirmer O. F., von der Linde D. // Appl. Phys. Lett. 1978. V. 33. N 1. P. 35—38.
- [6] Schirmer O. F. // G. Appl. Phys. 1979. V. 50. N 5. P. 3404—3406.
- [7] Sweeney K. L., Halliburton L. E. // Appl. Phys. Lett. 1983. V. 43. N 4. P. 336—338.
- [8] Halliburton L. E., Sweeney K. L., Chen C. J. // Nucl. Instrum. a. Meth. Phys. Res. B 1. 1984. V. B229. N 2—3. P. 344—347.
- [9] Братусь В. Я., Зарицкий И. М., Пекарь Г. С. и др. // ФТП. 1980. Т. 14. № 7. С. 1339—1342.
- [10] Абрагам А., Блини Б. Электронный парамагнитный резонанс переходных ионов. М., 1972. Т. 1. 652 с.